



# 1 N 4001 bis 1 N 4007

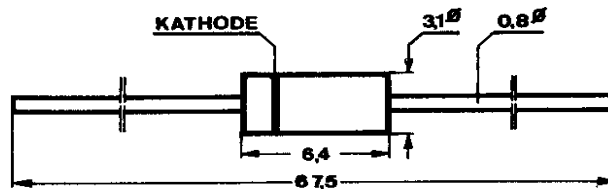
**Silizium-Diffusions-Dioden für universelle Anwendungen und kleine Leistungen.**

Silicon diffusion diode for low power general applications.

## Abmessungen · Dimensions

Maße in mm

M 2:1



Kunststoffgehäuse  
DO 7  
Gewicht · Weight  
max. 0,4 g

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

## Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Sperrspannungen

<b>1 N 4001</b>	$U_R = U_{RM}$	50	V
<b>1 N 4002</b>	$U_R = U_{RM}$	100	V
<b>1 N 4003</b>	$U_R = U_{RM}$	200	V
<b>1 N 4004</b>	$U_R = U_{RM}$	400	V
<b>1 N 4005</b>	$U_R = U_{RM}$	600	V
<b>1 N 4006</b>	$U_R = U_{RM}$	800	V
<b>1 N 4007</b>	$U_R = U_{RM}$	1000	V

Richtstrom

$I_O$  1 A

$U_R = 0 V$

Stoßdurchlaßstrom

$i_{FM}^{1)}$  30 A

Sperrschichttemperatur

$t_j$  175 °C

Lagerungstemperatur

$t_{stg}$  -65... + 175 °C

<sup>1)</sup> Gemessen im Abstand von je 25 mm vom Gehäuse

**AEG-TELEFUNKEN**

# 1 N 4001 bis 1 N 4007

## Wärmewiderstand · Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

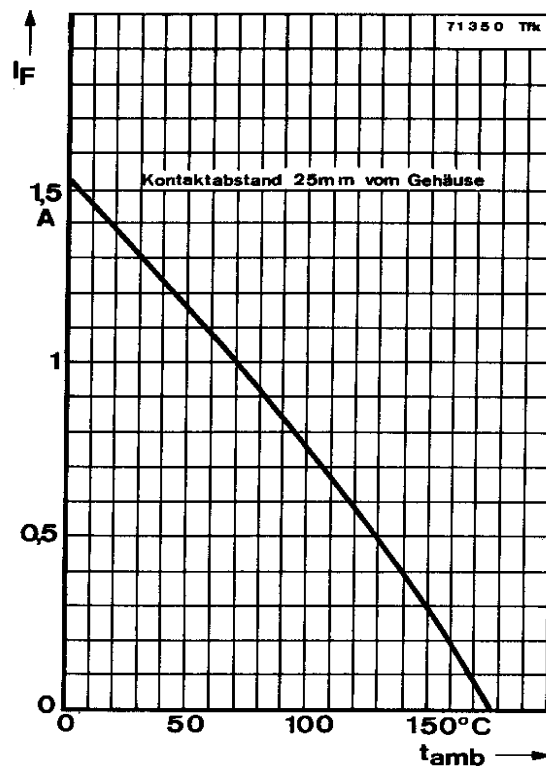
$R_{thJA}^{1)}$

$\leq 85$

$^{\circ}C/W$

## Kenngößen · Characteristics

		Min.	Typ.	Max.
Durchlaßspannung, Augenblickswert $i_F = 1 A, t_j = 25^{\circ}C$	$U_F^{*)}$			1,1 V
Durchlaßspannung, Arithmetischer Mittelwert $I_O = 1 A, t_{amb} = 75^{\circ}C^{1)}$	$U_{FAV}^{**)}$			0,8 V
Sperrstrom $U_R = U_{RM}; t_j = 25^{\circ}C$	$I_R^{*)}$			10 $\mu A$
$U_R = U_{RM}, t_j = 100^{\circ}C$	$I_R^{**)}$			50 $\mu A$
Sperrstrom, Arithmetischer Mittelwert $U_R = U_{RM}, t_{amb} = 75^{\circ}C^{1)}$ $I_O = 1 A$	$I_{RAV}^{**)}$			30 $\mu A$



\*) AQL = 0,65%, \*\*) AQL = 2,5%.

1) gemessen im Abstand von je 25 mm vom Gehäuse

# AEG-TELEFUNKEN